
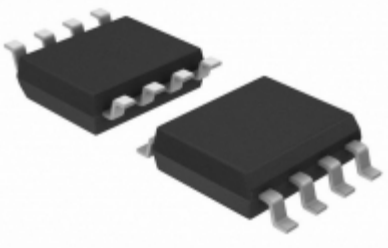
	<p>SI4160DY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4160DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 25.4A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4160DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 136040 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4160DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 25.4A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	136040 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5.7W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	25.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.9 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	54nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2071pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®



















































SI4160DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4160DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4160DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4160DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4160DY-T1-E3 VISHAY SI4160DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4162DY VISHAY SI4162DY VISHAY</p>	 <p>SI4160DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 25.4A 8-SOIC</p>	 <p>SI4158DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 36.5A 8-SOIC</p>
 <p>SI4162DY-T1 VISHAY VISHAY SO-8</p>	 <p>SI4160DY-T1-GE3 VISHAY SI4160DY-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI4158DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 36.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4160DY SI SI4160DY SI</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|--|--|---|
|  SI4133X1-BMR |  SI4134DY |  SI4134DY-T1 |  SI4134DY-T1-E3 |  SI4134DY-T1-E3 |
|  SI4134DY-T1-GE3 |  SI4134DY-T1-GE3 |  SI4134DY/T1/-GE3 |  SI4134T-BMR |  SI4134T-GMR |
|  SI4136-F-GM |  SI4136-F-GMR |  SI4136DY-T1-GE3 |  SI4136DY-T1-GE3 |  SI4136XM-BT |
|  SI4136XM-GTR |  SI4154DY-T1-GE3 |  SI4154DY-T1-GE3 |  SI4156DY |  SI4156DY-T1-E3 |
|  SI4156DY-T1-GE3 |  SI4156DY-T1-GE3 |  SI4160DY |  SI4160DY-T1-E3 |  SI4160DY-T1-GE3 |
|  SI4160DY-TI-GE3 |  SI4162DY |  SI4162DY-T1-E3 |  SI4162DY-T1-GE3 |  SI4162DY-T1-GE3 |
|  SI4164DY |  SI4164DY-T1-E3 |  SI4164DY-T1-GE3 |  SI4164DY-T1-GE3 |  SI4166DY |
|  SI4166DY-T1-E3 |  SI4166DY-T1-GE3 |  SI4166DY-T1-GE3 |  SI4168DY |  SI4168DY-T1-E3 |
|  SI4168DY-T1-GE3 |  SI4168DY-T1-GE3 |  SI4170DY-T1-GE3 |  SI4170DY-T1-GE3 |  SI4172DY |
|  SI4172DY-T1-E3 |  SI4172DY-T1-GE3 |  SI4172DY-T1-GE3 |  SI4174DY |  SI4174DY-T1-E3 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited